This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—4204

f)Int. Cl.³H 01 P 1/2037/08

識別記号

庁内整理番号 7741—5 J 7928—5 J ❸公開 昭和59年(1984)1月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

②特

願 昭57—112196

②出 願 昭57(1982)6月29日

⑫発 明 者 大井俊彦

日野市旭が丘3丁目1番地の1

東京芝浦電気株式会社日野工場

内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 木村高久

明 細 権

1. 発明の名称 帯域炉波器

2. 停許請求の範囲

容量性ギャップをコンデンサに置きかえたマイクロストリップライン構造の帯域炉波器において、コンデンサ取付電櫃と相対する蒸板裏側の接地電櫃を除去したことを特徴とする帯域炉波器。

3. 発明の詳細な説明。

〔発明の技術分野〕

との発明は、マイクロストリップラインを用いた容量性ギャップ結合伝送練路戸放器(キャパシティブギャップカップルドトランスミッションラインフィルタ)に関し、特にこの戸放器を800MHZ~1000MHZの比較的低い周放数で使用できるように容量性ギャップをコンデンサに置き換えて構成した帯域炉波器に調する。

〔発明の技術的背景〕

マイクロストリップラインを用いたキャパシティアカップルドトランスミッションラインフィルタという)は、所定長のマイクロストリップラインからなる複数の共扱器と、この共扱器間および共扱器と伝送路との間に形成されるマイクロストリップラインのギャップからなる結合容量によって構成される。

とのトランスミッションラインフィルタはチェビシェフ特性フィルタと同等に扱うととができる。 第1図はチェビシェフローパス特性フィルタの応答特性、第2図はその回路例、第3図はチェビシェフローパス特性フィルタの応答特性を第1図に示したチェビシェフローパス特性フィルタの応答特性に対応して示したものである。

トランスミッションラインフィルタによって、 館3回に示すようなチェピシェフパンドパス特性 フィルタの応答特性と問等のものを得るための共 撮路の数および共振器の長さおよび共振器間のギャップは、 Leo Young, George L. Matthael, E.M. T. Jones, の共者からなる Microwave Filters, Impedance—Matching Net-works, And Coupling Structores (出版社マッグロウーヒルブックカンパニー)にも示されているように周波数w。,w」,w。および周波数w。,w」,w。および周波数w。,w」,w。および周波数w。,w」,w。および周波数w。,wыにおける波表量LA。,帯域内のリップルおよび伝送路の特性インピーダンスを定めることにより以下のようにして求めることができる。すなわち、共扱器の数は

$$\begin{vmatrix} \frac{\omega'}{\omega_1} \end{vmatrix} = \frac{2}{\omega_x} \left(\frac{\omega_x - \omega_y}{\omega_z} \right) \qquad (2)$$

$$\omega_x = 2 \frac{\omega_z - \omega_z}{\omega_z + \omega_z} = \frac{B}{\omega_z} \qquad (3)$$

とし、式(1)に(2)(3)を代入することにより

₹0;伝送路の特性 インピーダンス

次に等価容量 B_{01} , B_{12} , B_{23} に相当するギャップ(第 5 図の Δ)は、次式

から求めることが出来る。

ただし、式 (10) で A はフィル 列中心間放数の 1 放長 b は基板の共振器と接地電極間の距離であり

$$\frac{B}{y_0} iz \quad \left| \frac{B}{y_0} \right| = \frac{J}{1 - \left(\frac{J}{y_0}\right)^z} \quad \dots \quad (11)$$

を得て、との式(4)式の値をもとにして抉めること ができる。

次に共振器の数を2と仮定して伝送路と共振器のギャップにもとづく等価容量(第4図のBoi, Bai)と共振器間のギャップにもとづく等価容量(第4図Bia)は、第1図、第2図においてチェビシェフフィルターの定数をωι'=1, βο=1, βι, βα, βα (フィルターの設計定数)とすれば、

と聞くことが出来る。

との式 (10)をΔについて解くと

$$\frac{B \cdot \lambda}{y_0 \cdot b} \approx \int_{0}^{\infty} \left(\cot h \frac{\pi \Delta}{s b} \right) = \log e \left(\cot h \frac{\pi \Delta}{s b} \right)$$

$$\cot h \frac{\pi \Delta}{s b} \approx e^{\frac{y_0 \cdot b}{y_0 \cdot b}} \approx \frac{\pi \cdot \Delta}{\pi \cdot \Delta}$$

となり、とこで

$$\cot h^{-1} e^{\frac{B \cdot \lambda}{y_0 \cdot b}} = \frac{1}{2} \log e^{\left(\frac{B \cdot \lambda}{y_0 \cdot b} + 1\right)} = K$$

と置くと

$$K \approx \frac{\pi \Delta}{1 \cdot b}$$

$$\Delta \approx \frac{2 \cdot b \cdot K}{\pi} \qquad (12)$$

となって式 (12)からギャップ △を計算すること ができる。

次に、共扱器の長さ ℓ_1 , ℓ_2 (解 ℓ_1 図) は、まず

特開昭59-4204(3)

位相角 θ 」、 θ ₄を次式(13)から求め、

$$\theta_{1} = \theta_{2} = \pi - \frac{1}{2} \left(\frac{2B_{j-1,j}}{y_{0}} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2B_{j,j+1}}{y_{0}} \right) (rad)$$

$$(13)$$

この位相角 0, 10 を式 (14) に代入することで求めることができる。

$$\ell_1 = \ell_2 = \theta_n \cdot \frac{\lambda}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{\theta_T}} \qquad (14)$$

fr は遊板の有する時能体の比 時間率

今帯域炉波器の中心周波数 ωο を 988 M H Z。 周波数 ω1 を 9 7 0 M H Z ,周波数 ω2 を 1 0 0 6 M H Z ,伝送路の特性インピーダンス Z₀ = 5 ο Ω (y ο = 0.0 2) ,帯域内リップルを 3 dB ,共銀器 の数を 2 とし、周波数 ω2 の点で 20 dB以上の減 変量 LA 2 を得るための周波数 ω2 を 9 2 8 M H Z

取付けた構成のトランスミッションラインフィルタを示したもので、 Y_{01} , Y_{04} は、マイクロストリップラインからなる伝送路、 Y_{02} , Y_{03} は所定長のマイクロストリップラインからなる共振器、 Y_{08} , Y_{06} , Y_{07} はコンデンサの取付パターン、 C_{1} , C_{2} , C_{3} , C_{4} , C_{5} , C_{6} はコンデンサである。

〔背景技術の問題点〕

第7図に示すように容量性ギャップをコンヂンサで置き換えてトランスミッションラインフィルタを構成すると、解8図にA-A断面図で示すように取付パターンYos,Yos,Yos と時配体 蒸板。「を介して相対する接地電極Ye 間に静電容量でYos,CYos,CYorを生じ、この静電容量が帯域炉波器の帯域幅を等価的に狭くするように動作する為に挿入損失を増加させるという問題が生じた。

すなわち取付パターンYos,Yos,Yosの寸法 をそれぞれ3mm×3mmとするとコンデンサ取付パターンと接地電価間容量は0.23 PF程度となり、 またこの帯域フィルターの挿入損失I、8 は 基板の厚さ 1.6 m , 導体の厚さ 0.036 m , 比勝電率を 4.7 とし、今まで述べた式を用いて各々の定数を計算すると第 6 図に示すようなトランスミッションラインフィルタが計算で求められる。ここで共扱器長 8_1 , 8_2 は式 (14) で、ギャップ Δ C_1 , Δ C_2 , Δ C_3 は式(5) 、(6) 、(7) 、(8) 、(9) 、(12) で求めることができる。

との計算によるとギャップ $_{\Delta}$ C₁, C₃に対応する等価容量は 0.43 PF、ギャップ $_{\Delta}$ C₁, $_{\Delta}$ C₃は 5.58×10^{-6} mm, またギャップ $_{\Delta}$ C₂対応する等価: 容量は 0.14 PF でギャップ $_{\Delta}$ C₃は 0.0206 mm となる。

しかし、とのような小幅のギャップは機械的に 実現困難である。そとでとのギャップにコンデン サを接続し、このコンデンサにより上記ギャップ に対応した等価容量を得る方法が考えられている。 とでコンデンサとしては高周波特性が良く、温 度特性コンデンサを用い酸コンデンサを必要に応 じて複数値直列にとりつける必要となる。

第7図は、とのようにギャップにコンデンサを

I,
$$S = 4.43 \cdot \frac{f_0}{B} \cdot \frac{f_1 \cdot f_2}{Q_u}$$
 (15)

Qu;無負荷Q

で求められ、

式(15)より 明らかなように取付面パターンと、 対接地面の静電容量により帯域が狭くなれば挿入 損失が増加するととになる。

との場合の等価回路は第9回に示される。

〔発明の目的〕

との発明は上述の点に鑑みてなされたもので、マイクロストリップライン構造の帯域炉波器の容量性ギャップをコンデンサへ置き換えるとともにこれによって生じる挿入損失を振力小さくした帯域炉波器を提供するととを目的とする。

(発明の概要)

そとで、この発明によれば、コンデンデ取付地 個と相対する基板製鋼の接地電極を除去すること によりコンデンサ取付電低と接地電板間に容量が 生じないようにし、これによって挿入損失の改善

特期昭59-4204 (4)

を計るようにしている。

(発明の実施例)

以下、この発明の実施例を忝付図面を参照して 詳細に脱明する。第10回,第11回はこの発明の 一実施例を示したもので、第10図はその平面図、 解 11 図は解 10 図に示すA-A断面図である。ま た第12図はこの実施例の等価回路図である。な お第10 図から第12 図において、第7 図から第9 図に示す回路と同一の機能を果す部分には脱明の 便宜上同一の符号を符する。すなわちYo1,Yo4 はマイクロストリップラインによる伝送路、Yoz, Youは所定長のマイクロストリップラインからな る共振器 C1 は伝送路 Yo1 と共扱器 Yo2 とをカッ ブリングするコンデンサ、Cェ, Cェ, Cィ, Cs は共 銀絡Yozと共振器Yosとをカップリングするコン デンサ、Ceは共振器Yosと伝送路Yoeとをカッ ブリングするコンデンサ、Yos, Yos, Yor はコ ンデンサC: C: C: C: を固定するための取 付けパターン、 ar は簡単体基板、Ye は接地パタ ーンである。また8iは信号源、Riはこの伊波器

接続し、入力高度放発振器の発振周波数を変化させるととにより測定できる。

第13 図はとのようにして側定したとの実施例の帯域严波器の周波数に対する相対波養量をコンデンサの取付けバターンYos,Yoe,Yotに対する接地バターンYeが除去されていない場合(第7 図から解8 図)に対応して示したものである。解13 図においてグラフA は接地バターンYe が除去されていない第7 図,解8 図に示した装置の特性を示すものである。グラフA とグラフB とを比較してみると接地電優がある場合に比較して接地電優を除去すると挿入損失がLidBだけ減少することが明らかとなる。

解 14 図、解 15 図は容量性 ギャップの代りに用いるコンデンサとしてリードタイプのチップコンデンサを用いた他の実施例を示したものである。 解 14 図、解 15 図 において、 Y₀₁₀ , Y₀₁₆ はマイクロストリップラインから構成される伝送路、 Y₀₁₁ , Y₀₁₆ は所定度のマイクロストリップライ の入力インピーダンスに整合する入力抵抗 R. は との炉波器の出力インピーダンスに整合する負荷 抵抗である。

この実施例の装置は第11 図に明確に示されているようにコンデンサを固定するための取付パターン Y_{05} , Y_{01} に誘電体基板 ϵ r を介して対応する接地パターン Y_{e} の一部を除去し、取付パターン Y_{05} , Y_{06} , Y_{07} と接地パターン Y_{e} 間に容量が生じないようにしたことを特徴としている。

との接地パターン Y_e が除去された部分は第11図では ℓ * o1 で表わされる区間であり、第10図では S_o 1 で示される。

このような構成をとることにより、取付けバターンYos・Yos・Yorと接地バターンYe 間の容量による帯域炉放器の帯域幅の減少を除去でき、これによる挿入損失の増加を防ぐことができる。 この帯域炉放器の特性は第12 図において信号

頒 Srとして、使用周波数帯域用の高周波発扱器

を接続し、抵抗 Ra に高間彼パルポルか電力計を

ンから構成される共振器、You, You, You, You, は、コンデンサの取付けパターン、Yeo は接地パターン、Cio, Cii, Cii, Cii, Cii, Cii, Cii, はコンデンサである。またSoi, &Soiは接地パターン除去部分および除去領域を示す。このような構成においても、解10図から解12図に 示した実施例と同様に動作し、挿入損失の減少をはかることができる。

(発明の効果)

以上脱明したように、この本発明によれば 900 MH2 帯又はそれより低い周波数で実現しにくかったキャパシティブギャップカップルドトランスミッションフィルタをギャップをコンデンサで置き換えることによって実現するとともに、これによってその際発生する挿入損失の増加をおさる。 とができ、小型化、低挿入損失が要求される、各種無線装置に好適な帯域が放器を提供することができる。

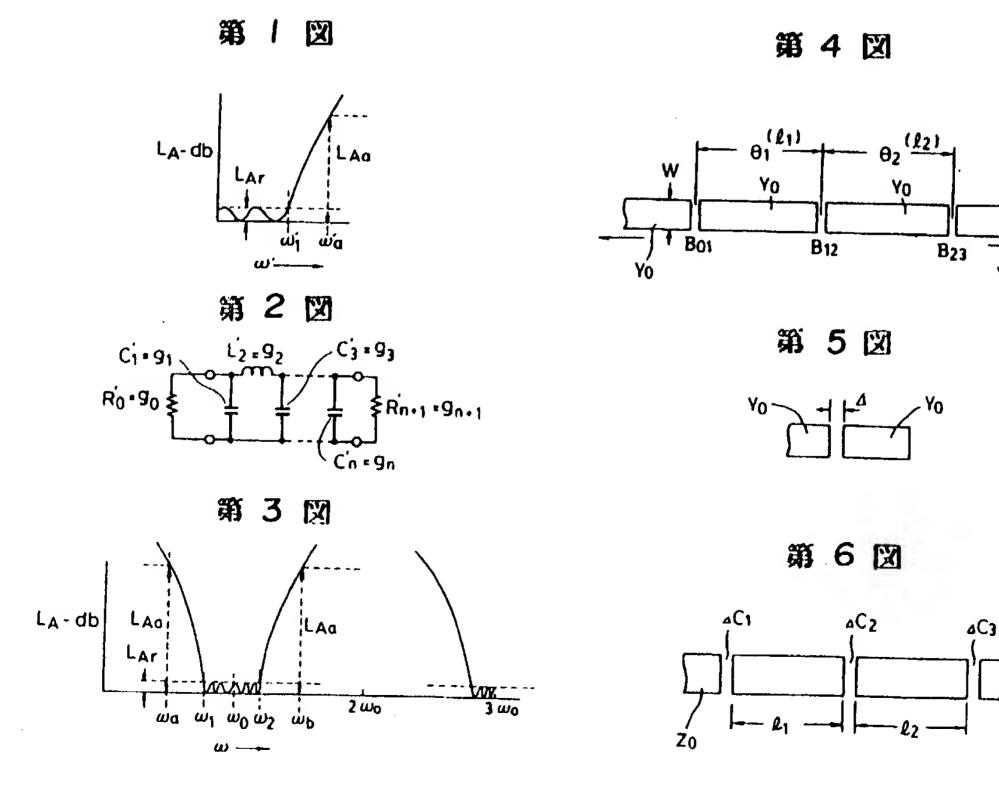
4. 図面の簡単な説明

特別昭59-4204(5)

You, You, You, …共級器、Ci~Co, Cio~Cis…コンデンサ、Yo, Yo, …接地パターン、Yo, Yo, Yo, Yoi, Yoi, Yoi, … 取付けパターン、8oi, 8oz…接地パターン除去部

第1図はこの発明を説明するためのチェビシェ フローパス特性フィルタの周波数応答特性を示す 図、第2図はチェビシェフローパス特性フィルタ を示す回路図、第3図はチェビシェフパンドパス 特性フィルタの周波数応答特性を示す図、第4図、 第5四、第6回はマイクロストリップラインによ るキャパシティブギャッブカップルドトランスミ ッションフィルタの構成を説明する図、麻7図、 第8回は容量性ギャップをコンダンサで置き換え た帯域炉波器の平面図およびそのA-A断面図、 解9回は第7回、第8回に示す帯域距波器の等個 回路図、第10図、第11図はこの発明の帯域伊波器 の一実施例を示す平面図およびそのA-A断面図、 第12回は第10回、第11回に示した実施例の帯域 炉波器の等価回路図、第13図は第10図、第11図 に示した実施例の特性を示す図、第14 図、第15 図はコンデンサをリードタイプのチップコンデン サで構成したとの発明の他の実施例を示す平面図 およびそのB-B断菌図である。

Yo1, Yo4, Yo10, Yo16 … 伝送路、Yos,



第10図

Y03

V01 V02 V03 V04

C1 V05 C3 V06 C4

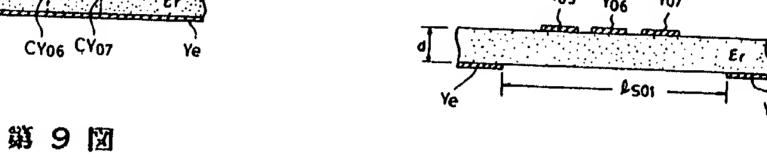
第7図

Yos Vo6 Vo7

Ye CY05 CY06 CY07 Ye

Er S01 Y05 C3 Y06 C4 Y07 C6

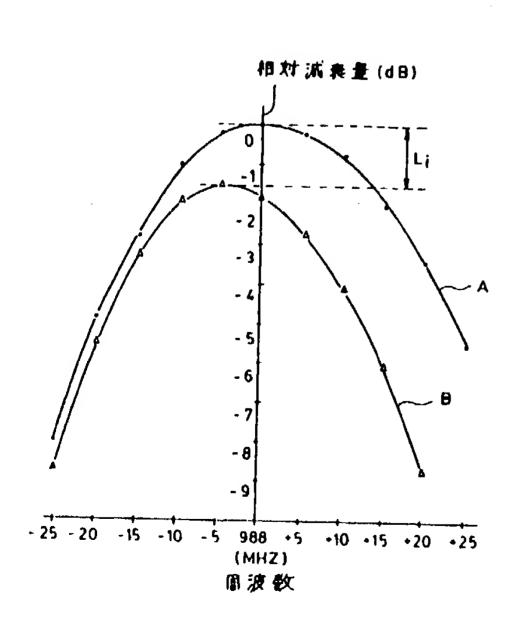
WOS Y06 Y07



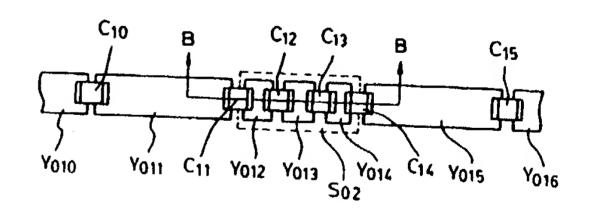
YO1 YO2 Y05 Y06 Y07 Y03 Y04

R1 C1 C2 C3 C4 C5 C6

第13図



第14図



第 15 図

